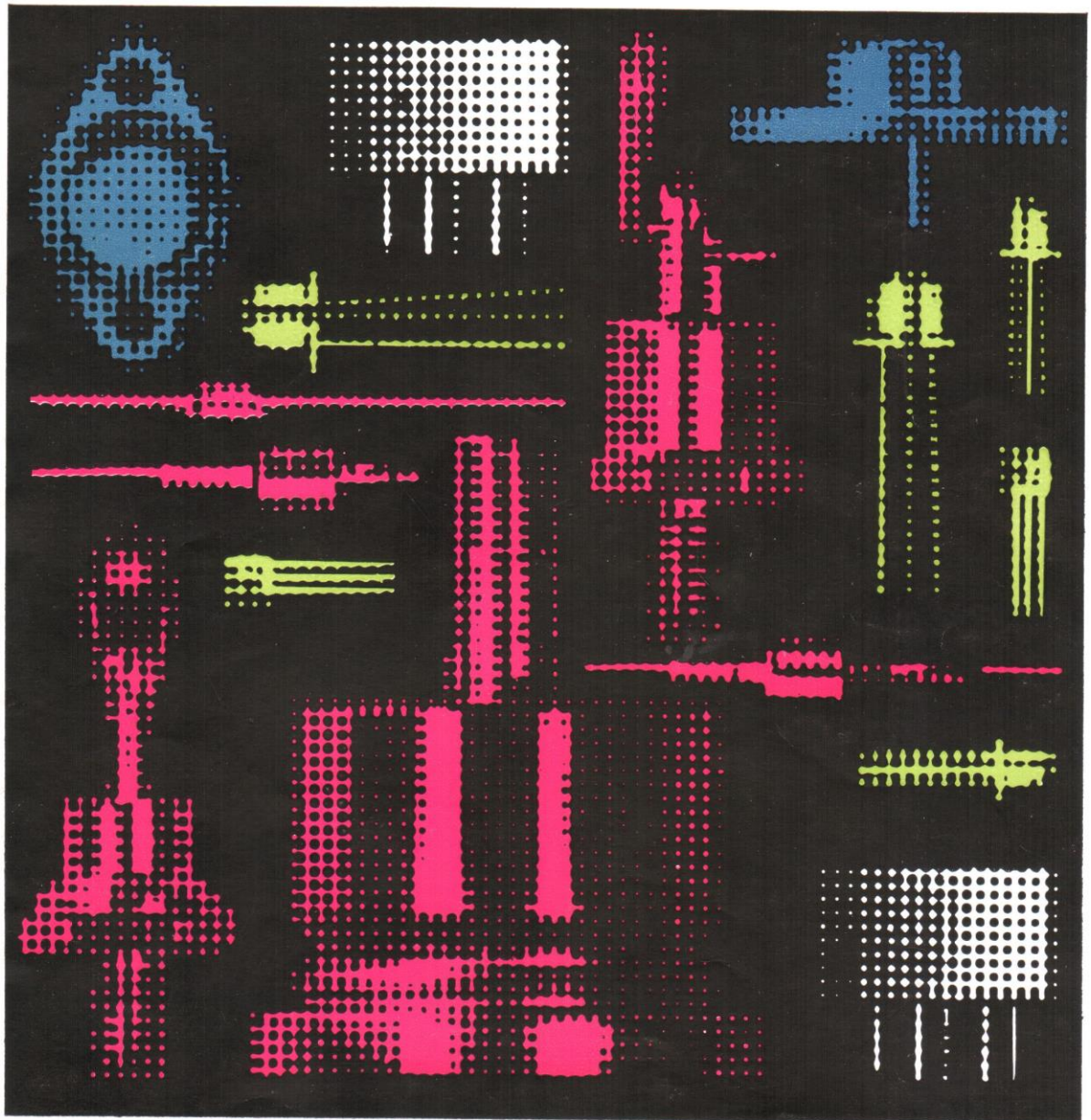


Halbleiter-Bauelemente



Ge-pnp-NF-Transistoren

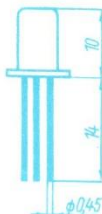
Typ	bei		bei		bei			bei			F/dB	$-U_{CE}/V$	$-I_C/mA$	R_s/Ω	f/kHz
	$-I_{CB0}/\mu A$	$-U_{CB}/V$	$-I_{EB0}/\mu A$	$-U_{EB}/V$	h_{21E}	$-U_{CE}/V$	$-I_C/mA$	f_T/MHz (f_β)	$-U_{CE}/V$	$-I_C/mA$					
GC 100	≤ 15	6	≤ 500	15				1	6	1	≤ 25	1	0,2	500	1
GC 101	≤ 15	6	≤ 500	15							≤ 10				
GC 112	≤ 18	15	≤ 50	10	≥ 10	6	2	$\geq 0,3$							
GC 116	≤ 18	15	≤ 50	10				$\geq 0,75$	6	2	≤ 20		0,3	500	1
GC 117	≤ 18	15						$\geq 1,2$			≤ 10	6			
GC 118	≤ 18	15						$\geq 1,2$			≤ 5				
GC 121	≤ 18	15	≤ 50		(28)			(0,012)							
GC 122	≤ 18	15	≤ 50	10	(18)	0,5	100	(0,012)	2	10					
GC 123	≤ 18	15	≤ 50		(18)			(0,012)							
GC 301	≤ 20 ≤ 250	6 32	≤ 50	10	(≥ 28)	1	350	(0,015)	2	10					

Ge-pnp-HF-Transistoren

Typ	bei		bei				bei				bei			
	$-I_{CB0}/\mu A$	$-U_{CB}/V$	V_{ab}/dB (G_{pb}/dB)	$-U_{CB}/V$	$-I_C/mA$	f/MHz	G_{ve}/dB (F/dB)	$-U_{CB}/V$	$-I_C/mA$	f/MHz	f_T/MHz	$-U_{CE}/V$ (V_{be}/dB)	$-I_C/mA$	f/MHz
GF 100	≤ 10	6					(≤ 15)	6	0,5	0,5				
GF 105	≤ 10						(≤ 20)	6	0,5	2				
GF 126	$\leq 7,5$										≥ 40	6	1	0,5
GF 128	$\leq 7,5$										≥ 100	10	3	100
GF 130	$\leq 7,5$										($\geq 27,5$)	6	1	10
GF 131	$\leq 7,5$	6					≥ 9							
GF 181	$\leq 7,5$						≥ 11	7	1,5	100				
GF 132	$\leq 7,5$		≥ 17	6	2	100					($\geq 27,5$)	6	1	10
GF 139	$\leq 7,5$													
GF 145	≤ 8	20	(≥ 9)	12	1,5	800	(≤ 9)	12	1,5	800	≥ 600	12	1,5	100
GF 147	≤ 8	20	($\geq 11,5$)	12	2	800	(≤ 6)	10	2	800	≥ 650	10	2	100



GC 100, 101
GC 112
GC 116-118
GC 121-123
GC 301
Masse $\approx 0,8$ g
GF 100, 105
Masse $\approx 0,8$ g



GF 126-139, 181
Masse $\approx 0,6$ g



GF 145, 147
Masse $\approx 0,4$ g